

---

# Compte Rendu

## TP CARACTÉRISATION ÉLECTRONIQUE

---

NICOLAS PAILLET & FÉLIX PIÉDALLU

2015-2016

14 Décembre 2015

# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>1 Rappels des équations</b>	<b>2</b>
<b>2 Mesure de la tension de seuil</b>	<b>3</b>
2.1 Transistor Bulk . . . . .	3
2.1.1 Méthode de la transconductance . . . . .	3
2.1.2 Méthode de la fonction Y . . . . .	3
2.2 Transistor FDSOI . . . . .	3
2.2.1 Méthode de la transconductance . . . . .	3
2.2.2 Méthode de la fonction Y . . . . .	3
<b>3 Mesure du DIBL</b>	<b>4</b>
<b>4 Comparaison des architectures</b>	<b>5</b>
<b>Conclusion</b>	<b>6</b>

# Introduction

Paramètres utilisés

## Chapitre 1

# Rappels des équations

## Chapitre 2

# Mesure de la tension de seuil

La tension de seuil est un paramètre important du transistor.

### 2.1 Transistor Bulk

#### 2.1.1 Méthode de la transconductance

#### 2.1.2 Méthode de la fonction Y

### 2.2 Transistor FDSOI

#### 2.2.1 Méthode de la transconductance

#### 2.2.2 Méthode de la fonction Y

## Chapitre 3

# Mesure du DIBL

## Chapitre 4

# Comparaison des architectures

# Conclusion